



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office ur péen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 051 172
A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 81108239.5

(51) Int. Cl.³: H 01 L 33/00

(22) Anmeldetag: 12.10.81

H 01 L 29/46, G 02 B 5/08

(30) Priorität: 03.11.80 DE 3041358

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin

und München
Postfach 22 02 61
D-8000 München 22(DE)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
12.05.82 Patentblatt 82/19

(72) Erfinder: Aengenheister, Jörg, Dipl.-Phys.
Münchner Kindl Weg 22
D-8000 München 90(DE)

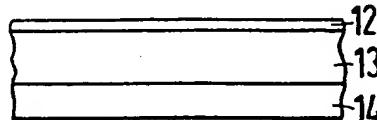
(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(72) Erfinder: Bacs, Laszlo
Ammerseestrasse 30
D-8021 Neuried(DE)

(54) Lichtreflektierender ohmscher Kontakt für Bauelemente.

(57) Es wird ein lichtreflektierender ohmscher Kontakt insbesondere für Lumineszenzdioden beschrieben, der aus einer Schichtenfolge mit einer ersten Schicht (12) aus Gold und Germanium im Gewichtsverhältnis 99 : 1, einer zweiten Schicht (13) aus reinstem Silber und einer dritten Schicht (14) aus reinstem Gold besteht. Die erste Schicht (12) ist etwa 0,02 µm dick, während die zweite und die dritte Schicht (13, 14) 0,8 µm bzw. 0,5 µm dick sind. Durch diese Schichtenfolge wird eine hohe Lichtreflexion bei geringem Widerstand erzielt. Beschrieben wird ferner ein Verfahren zur Herstellung des lichtreflektierenden ohmschen Kontaktes und dessen Verwendung.

FIG 2



EP 0 051 172 A1

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Berlin und München

Unser Zeichen
VPA 80 P 1178 E

- 7 -

5 Lichtreflektierender ohmscher Kontakt für Bauelemente

Die Erfindung betrifft einen lichtreflektierenden ohmschen Kontakt für Bauelemente, insbesondere Halbleiterbauelemente, bestehend aus einer Schichtenfolge einschließlich Gold auf einem Substrat.

Für den Wirkungsgrad von Lumineszenzdioden mit transparenten Substraten ist die Lichtreflexion an der Rückseite des Substrats von großer Bedeutung. Auf dieser Rückseite befindet sich gewöhnlich ein elektrischer Kontakt für die Stromzuführung zu einer Zone des einen Leitfähigkeitstyps des Substrats. Dieser Kontakt ist aber stark lichtabsorbierend, wenn er die gewünschten elektrischen Eigenschaften, nämlich einen niedrigen ohmschen Widerstand, hat. Um diese Lichtabsorption zu vermeiden, wird bisher die Rückseite des Substrats daher nur teilweise mit einem ohmschen Kontakt versehen. Durch die geringere Kontaktfläche werden aber insbesondere die elektrischen Eigenschaften beeinträchtigt, das heißt, am Übergang zwischen dem Kontakt und dem Substrat liegt ein Widerstand mit einer oft unerwünschten Höhe vor. Außerdem verringert sich durch die kleinere Kontaktfläche die Haltbarkeit des Kontakts am Substrat.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen lichtreflektierenden ohmschen Kontakt anzugeben, der bei hoher Lichtreflexion die gewünschten elektrischen Eigenschaften, also einen niedrigen ohmschen Widerstand, aufweisen soll.

Diese Aufgabe wird bei einem lichtreflektierenden ohmschen Kontakt der eingangs genannten Art erfindungsgemäß

Kot 1 Dx / 31.10.1980

- 2 - VPA 80 P 1178 E

dadurch gelöst, daß die Schichtenfolge eine erste Schicht aus Gold und Germanium im Gewichtsverhältnis etwa 99 : 1, eine zweite Schicht aus reinstem Silber und eine dritte Schicht aus reinstem Gold aufweist.

5

In vorteilhafter Weise ist die erste Schicht etwa 0,02 μ m (200 Å), die zweite Schicht 0,8 μ m und die dritte Schicht 0,5 μ m dick. Ein derartiger Kontakt ist insbesondere für Lumineszenzdioden vorteilhaft. Er ist 10 aber auch dann anwendbar, wenn ein Substrat mit einer lichtreflektierenden Schicht kontaktiert werden soll.

In vorteilhafter Weise wird dieser Kontakt so hergestellt, daß die einzelnen Schichten auf die Rückseite 15 des Substrats aufgedampft und anschließend dort angesintert werden. Der so hergestellte ohmsche Kontakt weist bei einem niedrigen ohmschen Widerstand eine hervorragende Lichtreflexion auf.

20 Nachfolgend wird die Erfindung an Hand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Leuchtdiode im Schnitt, und

Fig. 2 die Schichtenfolge des erfindungsgemäßen Kontakts.

25

In der Fig. 1 besteht ein Halbleitersubstrat 1 aus einer n-leitenden Zone 2 und einer p-leitenden Zone 3, die durch einen pn-Übergang 4 voneinander getrennt sind. Auf der Zone 3 ist ein Kontakt 5 angebracht, der mit einem Draht 6 als Zuleitung verbunden ist. Von der Oberfläche 7 dieser Zone 3 wird Licht abgestrahlt, wie dies durch Pfeile 8 angedeutet ist. Das Substrat 1 ist lichtdurchlässig. Um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen, sollte das im Substrat 1 und vorzugsweise am pn-Übergang erzeugte Licht von der Rückseite des Substrats 1 beziehungsweise der Zone 2 reflektiert werden und so über die

- 3 - VPA 80 P 1178 E

Oberfläche 7 das Substrat 1 verlassen. Hierzu ist der auf der Rückseite des Substrats 1 vorgesehene Kontakt 10 lichtreflektierend ausgestaltet, so daß dort das im Inneren des Substrats 1 erzeugte Licht reflektiert wird,

- 5 wie dies durch einen Pfeil 11 angedeutet ist.

Erfindungsgemäß besteht dieser Kontakt 10 aus einer Schichtenfolge (vergleiche Fig. 2) mit einer ersten, 0,02 μ m dicken Schicht 12 aus Gold und Germanium im Gewichtsverhältnis etwa 99 : 1, einer zweiten, 0,8 μ m dicken Schicht 13 aus reinstem Silber und einer dritten, 0,5 μ m dicken Schicht 14 aus reinstem Gold. Die Schicht 12 befindet sich dabei auf der Oberfläche der Zone 2.

- 15 Die einzelnen Schichten werden ganzflächig auf die Oberfläche der Zone 2 nacheinander aufgedampft. Anschließend werden diese Schichten gesintert. Der so hergestellte Kontakt hat die gewünschten Eigenschaften einer hohen Lichtreflexion und eines niedrigen ohmschen Widerstands.

2 Figuren

4 Patentansprüche

Patentansprüche

1. Lichtreflektierender ohmscher Kontakt für Bauelemente, insbesondere Halbleiterbauelemente, bestehend aus einer Schichtenfolge einschließlich Gold auf einem Substrat, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtenfolge eine erste Schicht (12) aus Gold und Germanium im Gewichtsverhältnis etwa 99 : 1, eine zweite Schicht (13) aus reinstem Silber und eine dritte Schicht (14) aus reinstem Gold aufweist.
2. Kontakt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Schicht (12) etwa 0,02 μ m (200 Å), die zweite Schicht (13) 0,8 μ m und die dritte Schicht (14) 0,5 μ m dick ist.
3. Verwendung des Kontakts nach Anspruch 1 oder 2 für Lumineszenzdioden (1).
4. Verfahren zur Herstellung des Kontakts nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Schichten (12, 13, 14) auf die Rückseite des Substrats (1) aufgedampft und anschließend angesintert werden.

0051172

1/1

FIG 1

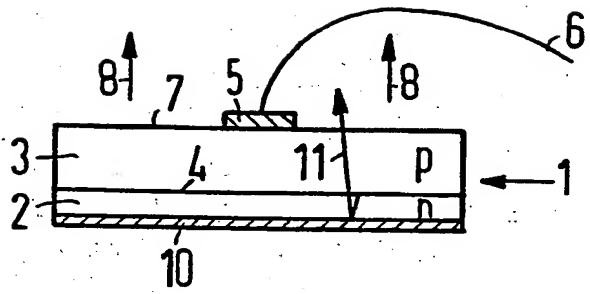
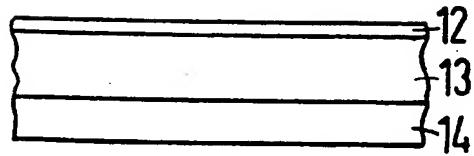


FIG 2



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 81108239.5

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
	<p><u>DE - A1 - 2 702 935 (HITACHI)</u> * Fig. 4e; Seite 14, Zeilen 13-16 *</p> <p>--</p> <p>IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, Oktober 1976, New York HEINEN, WESTERMEIER, HARTH, ZSCHAUER: "Proton Bombarded GaAlAs: GaAs Light Emitting Diodes" Seite 1186</p> <p>* Fig. 1 *</p> <p>--</p> <p><u>DE - B2 - 2 045 106 (SIEMENS)</u> * Spalte 2, Zeilen 43-45 *</p> <p>--</p> <p><u>US - A - 3 931 631 (MONSANTO)</u> * Spalte 4, Zeilen 49-51 *</p> <p>--</p> <p><u>DE - B1 - 2 445 763 (SIEMENS)</u> * Fig. 2; Spalte 2, Zeilen 30-60 *</p> <p>-----</p>	1,3,4	H 01 L 33/00 H 01 L 29/46 G 02 B 5/08
A		1,3,4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)
A		1,3,4	H 01 L G 02 B
A		1,2,4	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			
X	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.		
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prufer	
WIEN	19-01-1982	HEINICH	

THIS PAGE BLANK (USPTO)